

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
<p>[4]2-クロロニトロベンゼン</p>	<p><b>【底質】</b></p> <pre> graph LR     A["底質試料 湿泥 (乾泥換算約10g)"] --&gt; B["精油定量器抽出 精製水 300mL ヘキサン 10mL 90分"]     B --&gt; C["遠心分離 1,500rpm、5分間"]     C --&gt; D["脱水 無水硫酸ナトリウム"]     D --&gt; E["濃縮 窒素パーズ 1mLまで"]     E --&gt; F["カラムクリーンアップ 5%含水シリカゲル 5g 予備洗浄:ヘキサン 50mL 妨害物質除去:ジクロロメタン/ヘキサン(10:90) 10mL 溶出:ジクロロメタン/ヘキサン(10:90) 30mL"]     F --&gt; G["濃縮 窒素パーズ 1mL未満まで"]     G --&gt; H["定容 ヘキサン 1mL"]     I["シリンジスパイク添加 4-クロロニトロベンゼン-d4 50ng"] --&gt; H     H --&gt; J["GC/MS-SIM-EI"]           </pre> <p>「平成19年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠</p>	<p>分析原理：GC/MS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【底質】 (ng/g-dry) [4] 0.22</p> <p>分析条件： 機器 GC：HP6890 MS：HP5973MSD カラム DB-1701 30m×0.25mm、0.25μm</p>
	<p><b>【大気】</b></p> <pre> graph LR     A["大気"] --&gt; B["捕集 Tenax TA 0.1L/分×24時間"]     B --&gt; C["加熱・脱離 濃縮・導入 260℃ 60mL/分 10分間"]     C --&gt; D["濃縮・脱離 濃縮：-100℃ 脱離：260℃、10分間"]     D --&gt; E["GC/MS-SIM-EI"]           </pre> <p>「平成19年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠</p>	<p>分析原理：加熱脱着GC/MS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【大気】 (ng/m<sup>3</sup>) [4] 0.12</p> <p>分析条件： 機器 GC：Agilent 6890 MS：Agilent 5973MSD カラム HP-5MS 30m×0.25mm、0.25μm</p>